

a 2007 0192

Invenția se referă la procedeele de prelucrare termică a materialelor semiconductoare și poate fi folosită în microelectronică.

Esența invenției constă în modificarea straturilor de suprafață ale monocristalelor de seleniură de zinc, care include prelucrarea termică a monocristalelor în topitură de bismut cu adaos de 0,02...1,10% at. de crom la temperatura de 1000...1200°C timp de 60...150 de ore.

Rezultatul constă în lărgirea posibilităților funcționale ale dispozitivelor, obținute în baza monocristalelor de seleniură de zinc dopate cu crom din topitură de bismut, precum și în îmbunătățirea stoichiometriei în procesul dopării.

Revendicări: 1

Figuri: 2